

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**  
**HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANI**

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japonya

**DERHAL YAYINLANACAKTIR**

**No. 3053**

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

*Müşteri İlişkileri*

Yarı İletken & Cihaz Pazarlama Böl. B  
Mitsubishi Electric Corporation

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/)

*Medya İlişkileri*

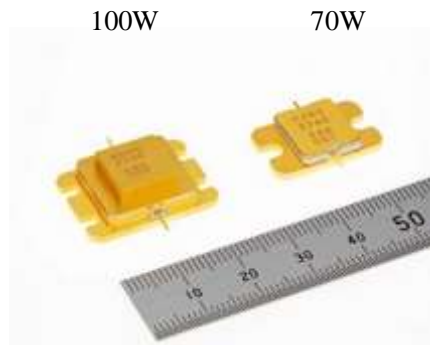
Halkla İlişkiler Departmanı  
Mitsubishi Electric Corporation  
[prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp)  
[www.MitsubishiElectric.com/news/](http://www.MitsubishiElectric.com/news/)

**Mitsubishi Electric Ku-band GaN-HEMT Serisini Genişletecek**

*Yeni modellerin yüksek çıkış gücü uydu yer istasyonlarının boyutunun  
küçültülmesine yardımcı olacak*

**TOKYO, 27 Eylül 2016** – [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKYO: 6503) bugün Galyum Nitrid Yüksek Elektronlu Mobilite Transistörü (GaN-HEMT) serisini Ku-band\* bulunan uydu yer istasyonlarında kullanılmak üzere 100W ve 70W çıkış gücü ile tasarlanan üniteleri içerecek şekilde genişleteceğini açıkladı. Yeni 100W GaN-HEMT, Mitsubishi Electric'in 27 Eylül'de yaptığı araştırmaya göre mevcut olan en yüksek çıkış gücüne sahip transistörlerden biridir. Mitsubishi Electric 1 Ekim'de numunelerin sevkiyatına başlayacak.

\* 12-18GHz aralığında mikrodalga bant



Sol: MGFK50G3745 Sağ: MGFK48G3745

Doğal afetler gibi olumsuz koşullarda ve iletişim tesislerinin inşa edilmesinin güç olduğu yerlerde dahi özellikle Ku-band'da yüksek hızlı iletişimi mümkün kılan uydu iletişimine yönelik talepte artış yaşanıyor. Daha yüksek çıkış gücü olan GaN-HEMT'leri kullanan verici ekipmanları, özellikle uydudan haber toplama gibi yüksek hızlı uygulamalarda son yıllarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mitsubishi Electric, daha yüksek çıkış gücü seviyeleri için artan talebi karşılamak üzere sektör lideri 100W çıkış gücüne sahip MGFK50G3745 modeli ile 70W çıkış gücüne sahip MGFK48G3745 modelinin lansmanıyla Ku-band GaN-HEMT serisini genişletiyor.

## Ürün Özellikleri

### 1) *Sektör lideri çıkış gücü minyatürleştirmeye katkıda bulunur*

- 100W çıkış gücüne sahip MGFK50G3745 modeliyle transistör yapısı optimizasyonu, Ku-band'ın kullanıldığı uydu yer istasyonları için idealdir
- GaN-HEMT'lerde daha az parça kullanılarak, uydu yer istasyonlarında verici ekipmanlarının minyatürleştirilmesine katkıda bulunulmuştur

### 2) *Ürün serisinin genişlemesini ve farklı ihtiyaçlara yanıt verilmesini sağlar*

- Yeni 100W ve 70W modeller, uydu yer istasyonlarının verici ekipmanları için çıkış gücü değerlerinde daha fazla çeşitlilik ihtiyacına yanıt veriyor
- Münferit verici bileşenleri, üretim sırasında bağımsız bir şekilde konfigüre edilebilir ve böylelikle yerinde konfigürasyon ihtiyacını ortadan kaldırarak genel geliştirme sürelerini kısaltır
- Mevcut MGFG5H1503 güç amplifikatörünü sürücü katı olarak kullanarak amplifikatörün doğrusallaştırma cihazını destekler ve böylelikle güç vericilerinde bozulmayı azaltmaya yardımcı olur

## Satış Takvimi

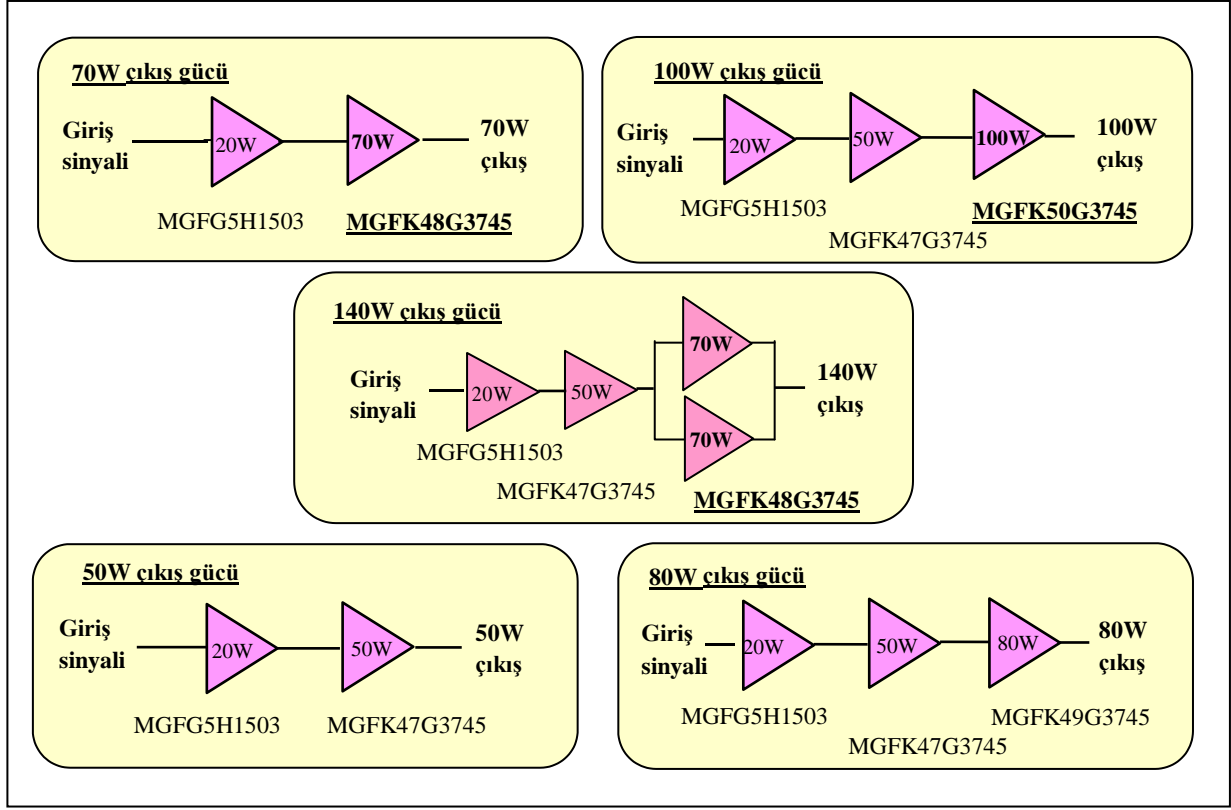
Ürün	Uygulama	Model	Genel Bilgi			Sevkiyat
			Frekans	Doymuş çıkış gücü	Lineer kazanç	
Ku-band GaN-HEMT'ler	Uydu yer istasyonları	MGFK50G3745	13.75–14.5 GHz	50.0dBm (100W)	10.0dB	1 Ocak 2017
		MGFK48G3745		48.3dBm (70W)	10.0dB	1 Ekim 2016

## Seride ve Temel Spesifikasyonlarda Yapılan Revizyonlar (yeni modeller kalın harflerle belirtilmiştir)

Ürün	Model	RF performansları		
		Doymuş çıkış gücü		Lineer kazanç
		[dBm]	[W]	[dB]
Ku-band GaN-HEMT'ler	MGFG5H1503**	43.0	20	20.0
	MGFK47G3745	47.0	50	8.0
	<b>MGFK48G3745</b>	<b>48.3</b>	<b>70</b>	<b>10.0</b>
	MGFK49G3745	49.0	80	7.5
	<b>MGFK50G3745</b>	<b>50.0</b>	<b>100</b>	<b>10.0</b>

\*\* Dahili doğrusallaştırıcı

### Ku-band güç vericisi için GaN HEMT konfigürasyonu örneği



### Temel Spesifikasyonlar

Temel özellikler		Sembol	MGFK50G3745	MGFK48G3745
Tavsiye edilen durum	Drenaj kaynağı voltajı	VDS	24V	24V
	Drenaj akımı	IDQ	2.4A	1.44A
Frekans		13.75–14.5GHz (Ku-band)		
Doymuş çıkış gücü		Pout Tipi	100W	70W
Lineer kazanç		GL Tipi	10.0dB	10.0dB
İlave güç verimliliği		PAE	%30	%33

### Cevresel Farkındalık

Bu ürünler, 2011/65/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması'na (RoHS) uygundur.

Not: Bu ürünlerin geliştirilmesine Japonya Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Örgütü (NEDO) kısmi destek vermiştir.

###

### **Mitsubishi Electric Corporation Hakkında**

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3 milyar yen (38.8 milyar US\$\*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.: [www.MitsubishiElectric.com](http://www.MitsubishiElectric.com)

\* Tokyo Döviz Borsasının 31 Mart 2016’da ilan ettiği 1 USD =113 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.